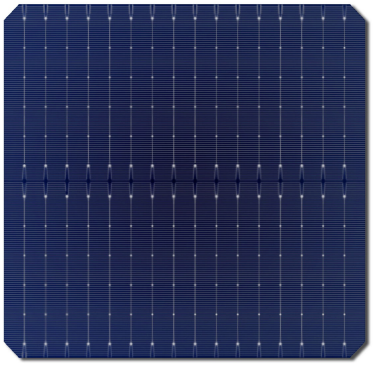
HS-182-16BB
N型TOPCon

高效双面单晶电池



产品特性

无光致衰减
高品质N型硅片，无B-O复合键，0光致衰减

高转化效率
正面效率≥25.2%，双面率≥80%

更优温度系数
改善高温情况下的发电性能，发电能力提升可达1%

弱光性能强
提高早晚及阴雨天气等弱光条件下的发电性能

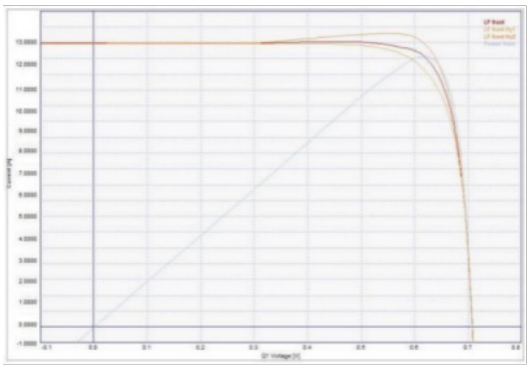
封损低
封损更低，更适宜高效组件

高可靠性
通过更加严苛的测试，使得组件在高寒、沙漠、滩涂等严苛环境也拥有更好的持续性

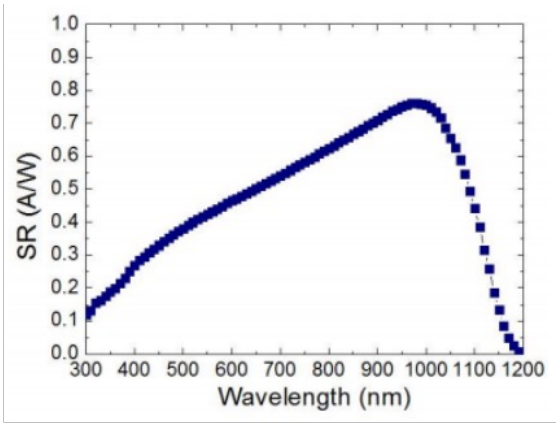
技术数据与设计

尺寸	182mm*182mm±0.25mm，Φ247mm±0.25mm	TkVoltage：-0.26%/K
厚度	145±15	TkCurrent：+0.046%/K
正面(+)	16*0.04±0.03mm主栅线(银)，116根副栅线，蓝（深蓝）色抗反射膜(氮化硅)	TkPower：-0.32%/K
背面(-)	16*0.04±0.03mm主栅线(银)，120根副栅线，蓝（深蓝）色抗反射膜(氮化硅)	Rsh≥50Ω，Irev2≤0.8A

IV曲线



光谱响应



正面电性能参数

效率代码	效率 Eff (%)	最大输出功率Pmpp (W)	最大输出电压Umpp (V)	最大输出电流Impp (A)	开路电压 Uoc (V)	短路电流 Isc (A)	填充因子 FF (%)
HS-182M-252	25.2	8.32	0.626	13.291	0.714	13.776	84.59
HS-182M-251	25.1	8.30	0.625	13.279	0.713	13.766	84.50
HS-182M-250	25.0	8.27	0.624	13.252	0.712	13.748	84.47
HS-182M-249	24.9	8.23	0.623	13.212	0.711	13.741	84.31
HS-182M-248	24.8	8.20	0.622	13.185	0.709	13.729	84.22
HS-182M-247	24.7	8.16	0.622	13.119	0.709	13.730	83.81
HS-182M-246	24.6	8.13	0.621	13.098	0.709	13.716	83.69
HS-182M-245	24.5	8.10	0.620	13.062	0.707	13.708	83.54
HS-182M-244	24.4	8.06	0.620	13.007	0.707	13.705	83.23
HS-182M-243	24.3	8.02	0.618	12.985	0.706	13.694	82.92
HS-182M-242	24.2	7.99	0.617	12.951	0.705	13.689	82.86
HS-182M-241	24.1	7.97	0.617	12.921	0.705	13.646	82.85
HS-182M-240	24.0	7.93	0.616	12.875	0.704	13.624	82.68
HS-182M-239	23.9	7.89	0.616	12.809	0.704	13.558	82.67
HS-182M-238	23.8	7.86	0.615	12.777	0.703	13.526	82.64
HS-182M-237	23.7	7.82	0.615	12.723	0.703	13.472	82.62

标准测试条件：1000W/m^2，AM1.5，25℃

以上技术参数受限于技术变更及测试，合盛硅业保留最终解释权。

正面电性能参数

效率代码	效率 Eff (%)	最大输出功率 Pmpp (W)	最大输出电压 Umpp (V)	最大输出电流 Impp (A)	开路电压 Uoc (V)	短路电流 Isc (A)
HS-182M-20.5	> 20.5%	6.77	0.619	10.934	0.705	11.41
HS-182M-20.3	20.3%-20.5%	6.7	0.617	10.862	0.703	11.377
HS-182M-20.1	20.1%-20.3%	6.64	0.615	10.79	0.701	11.344
HS-182M-20.0	< 20.1%	6.6	0.614	10.754	0.7	11.323

标准测试条件：1000W/m^2，AM1.5，25℃

以上技术参数受限于技术变更及测试，合盛硅业保留最终解释权。